## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-183247

(43)Date of publication of application: 14.07.1998

(51)Int.Cl.

C21D 8/12 C22C 38/00 C22C 38/06

(21)Application number: 08-347762

(71)Applicant: NIPPON STEEL CORP

(22)Date of filing:

26.12.1996

(72)Inventor: ABE TOMOYUKI

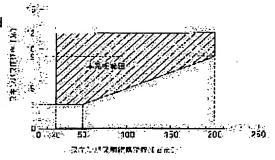
SENOO SEIICHI

YAMAMOTO MASAHIRO

# (54) PRODUCTION OF NONORIENETED SILICON STEEL SHEET HIGH IN MAGNETIC FLUX DENSITY IN LOW MAGNETIZING FORCE

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a stock high in magnetic flux density in low magnetizing force. SOLUTION: As for the method for producing a nonoriented silicon steel sheet, a steel contg., by weight,  $\leq$ 0.010% C, 0.1 to 2.0% Si,  $\leq$ 1.5% Mn,  $\leq$ 1.0% Al,  $\leq$ 0.15% P,  $\leq$ 0.01% S and ≤0.01% N, contg., at need, Ni, Sn and Cu, and the balance Fe with inevitable impurities is subjected to hot rolling, is subjected to cold rolling for one time or ≥ two times including process annealing as it is without executing hot rolled sheet annealing or after hot rolled sheet annealing or self-annealing, is thereafter annealed, is subsequently subjected to skinpass cold rolling and is thereafter annealed. The skinpass cold rolling is executed under the conditions of 3 to 12% in the case the grain size before the skinpass is 20 to <50 µm or 12% ≥ skinpass rate [%] ≥0.04 × the grain size [µm] before the skinpass + 1 in the case it is 50 to 200 µm.



# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平10-183247

(43)公開日 平成10年(1998)7月14日

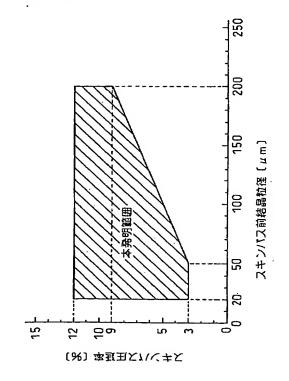
(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	<b>F</b> I
C21D 8	/12	C 2 1 D 8/12 A
C 2 2 C 38	/00 3 0 3	C 2 2 C 38/00 3 0 3 U
38	/06	38/06
H01F 1		H01F 1/16 A
		審査請求 未請求 請求項の数2 〇L (全 5 頁)
(21)出願番号	特願平8-347762	(71) 出願人 000006655
		新日本製鐵株式会社
(22)出顧日	平成8年(1996)12月26日	東京都千代田区大手町2丁目6番3号
		(72)発明者 阿部 智之
		福岡県北九州市戸畑区飛幡町1-1 新日
		本製鐵株式会社八幡製鐵所内
		(72)発明者 妹尾 聖一
		福岡県北九州市戸畑区飛幡町1-1 新日
		本製鐵株式会社八幡製鐵所內
		(72)発明者 山本 政広
		福岡県北九州市戸畑区飛幡町1-1 新日
		本製鐵株式会社八幡製鐵所內
		(74)代理人 弁理士 石田 敬 (外3名)

### (54) 【発明の名称】 低磁化力での磁束密度が高い無方向性電磁網板の製造方法

#### (57)【要約】

【課題】 低磁化力での磁束密度の高い素材を提供する。

【解決手段】 重量% で、C  $\leq$ 0.010%、0.1% $\leq$ Si  $\leq$ 2.0%、 $Mn\leq$ 1.5%、 $A1\leq$ 1.0%、 $P\leq$ 0.15%、 $S\leq$ 0.01%、 $N\leq$ 0.01%、必要に応じNi、Sn、Cuを含有し、残部はFe及び不可避的不純物からなる鋼を、熱間圧延後、そのまま熱延板焼鈍なしに、もしくは熱延板焼鈍、もしくは、自己焼鈍を施し、一回または中間焼鈍を挟む二回以上の冷間圧延をおこなった後、焼鈍を行ない、引続きスキンパス冷延後に焼鈍を施す無方向性電磁鋼板の製造方法において、スキンパス前の結晶粒径が、 $20~\mu$ m 以上 $50~\mu$ m 未満の場合には3%以上12% 以下、または、 $50~\mu$ m 以上200  $\mu$ m 以下の場合は、12%  $\geq$ 2、キンパス率[%]  $\geq$ 0.04×スキンパス前結晶粒径[ $\mu$ m]+10条件でスキンパス冷延することを特徴とする低磁化力での磁束密度が高い無方向性電磁鋼板の製造方法。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 重量% で、

C ≤0.010%

0.1%≦Si≦2.0%、

Mn≦1.5%、

A1≦1.0%\

 $P \le 0.15\%$ 

 $S \leq 0.01\%$ 

 $N \leq 0.01\%$ 

を含有し、残部はFe及び不可避的不純物からなる鋼を、 熱間圧延後、そのまま熱延板焼鈍なしに、もしくは熱延 板焼鈍、もしくは、自己焼鈍を施し、一回または中間焼 鈍を挟む二回以上の冷間圧延をおこなった後、焼鈍を行 ない、引続きスキンパス冷延後に焼鈍を施す無方向性電 磁鋼板の製造方法において、スキンパス前の結晶粒径 が、

20 μm 以上50 μm 未満の場合には、スキンパス冷延率3% 以上12% 以下、または、

 $50 \mu m$  以上 $200 \mu m$  以下の場合は、 $12\% \ge 2$ スキンパス冷延率[%]  $\ge 0.04 \times 2$ スキンパス前結晶粒径[ $\mu m$ ]+1の条件でスキンパス冷延することを特徴とする低磁化力での磁束密度が高い無方向性電磁鋼板の製造方法。

【請求項2】 重量% で、更に前記鋼が、

Ni≦2.0%、

Sn≦0.50%、

Cu≦1.0%

を含有することを特徴とする請求項1 記載の低磁化力での磁束密度が高い無方向性電磁鋼板の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0.001]

【発明の属する技術分野】本発明は、低磁化力での磁束 密度が高い無方向性電磁鋼板の製造方法に関するもので ある。

#### [0002]

【従来の技術】従来、鉄損を下げる目的で、スキンパス 冷延がおこなわれてきた。そのうち、スキンパス冷延前 の結晶粒径が開示されている従来技術として、以下の先 行技術が挙げられる。特開平2-179823号公報では、冷延 後の仕上連続焼鈍を再結晶以上~平均結晶粒径20μm未 満となる条件でおこなった後、3~15%の最終スキンパ 40 ス冷延を施す無方向性電磁鋼板の製造方法が提示されて いる。

【0003】また、特開平1-191741号公報では、熱延板を焼鈍後、3~15%スキンパス冷延し、さらに熱延板を焼鈍し、冷間圧延する無方向性電磁鋼板の製造方法が提示されている。これは、熱延板にスキンパス冷延した後、熱延板の結晶粒径をある値以上にし、磁性を改善する技術である。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】モータの高効率化の要 50

求が高まるにつれ、モータの設計磁束密度を下げてでも 高効率化をはかるモータが必要になってきた。その結 果、それらモータに使用される無方向性電磁鋼板に対し て、低磁化力での磁束密度の高い素材が求められるよう になってきた。この要求を満足するには、最終製品(ス キンパス冷延に続く焼鈍後の材料)の結晶粒径を十分に 粗大化する必要がある。

【0005】ところが、特開平2-179823号公報や特開平1-191741号公報に開示されているような従来の技術では、この要求に応えられない。特開平2-179823号公報の方法では、スキンパス冷延に続く焼鈍後の結晶粒径が充分に粗大にならず、低磁化力での磁束密度が向上しない。また、特開平1-191741号公報では、熱延板の結晶粒径は粗大化するものの最終製品の粒径を粗大化する技術ではない。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】そこで、本発明者らは、 上記問題に鑑み、鋭意検討を行った結果、スキンパス冷 延前の結晶粒径とスキンパス冷延圧下率を制御すること 20 により、上記課題を解決できることを究明した。その内 容は以下の通りである。重量% で、C ≤0.010%、0.1%≤  $Si \le 2.0\%$ ,  $Mn \le 1.5\%$ ,  $A1 \le 1.0\%$ ,  $P \le 0.15\%$ ,  $S \le 0.01$ %、N ≤0.01%、を含有し、残部はFe及び不可避的不純 物からなる鋼を、熱間圧延後、そのまま熱延板焼鈍なし に、もしくは熱延板焼鈍、もしくは、自己焼鈍を施し、 一回または中間焼鈍を挟む二回以上の冷間圧延をおこな った後、焼鈍を行ない、引続きスキンパス冷延後に焼鈍 を施す無方向性電磁鋼板の製造方法において、スキンパ ス前の結晶粒径が、20μπ以上50μπ未満の場合にはス 30 キンパス冷延率3%以上12%以下、または、50μm以上20 0 μm 以下の場合は、12% ≧スキンパス冷延率[%] ≥0. 04×スキンパス前結晶粒径[ μm]+1の条件でスキンパス 冷延することを特徴とする低磁化力での磁束密度が高い 無方向性電磁鋼板の製造方法である。

【0007】また、上記鋼に重量%で、Ni≦2.0%、Sn≦0.50%、Cu≦1.0%を含有することを特徴とする上記記載の低磁化力での磁束密度が高い無方向性電磁鋼板の製造方法である。

#### [0008]

【発明の実施の形態】以下に本発明の詳細を説明する。 まず、本発明の成分限定理由について述べる。C は、鉄 損を増加させる有害な成分で、磁気時効の原因となるの で、0.010%以下とする。

【0009】Siは周知のように鉄損を下げるのに有効な元素であり、この効果を得るためには0.1%以上含有させる必要がある。一方、その含有量が増えると磁束密度が低下し、また、圧延作業性の劣化、仕上げ焼鈍温度の上昇を招き、さらにはコスト高ともなるので2.0%以下とする。MnはSiと同様に鉄損を下げるのに有効な元素ではあるが、1.5%超になると磁束密度が下がるので1.5%以下と

する。 Mnが0.05% 以下では磁気特性が劣化するので下限 は0.05% とする。

【0010】AlはSiと同様に、固有抵抗を高めて鉄損を下げる効果があるため、含有させても良いが、本発明においてはSiにより固有抵抗を高めればよいので特に下限はもうけない。一方、Al含有量が増えると磁束密度が低下するので、1.0%以下とする。また、Alには、固溶Nを低減させ、窒化物の微細析出を抑制する効果ももたせているため、Alの少ない場合にはBを添加し、NをBNの形で粗大析出させて無害化させることも本発明を損なわない。

【0011】Pは、0.15%を越えると鉄損を大きくするので0.15%以下とする。Sは0.01%を越えるとMnSなどの硫化物が微細に析出し、仕上げ焼鈍時の粒成長を阻害し、鉄損を大きくするので0.01%以下とする。Nは0.01%を越えるとAINなどの窒化物が微細に析出し、仕上げ焼鈍時の粒成長を阻害し、鉄損を大きくするので0.01%以下とする。

【0012】Niは飽和磁化を向上させ、集合組織を改善するので添加するが、過剰添加はコストアップを招くの 20で2%以下とする。Snは集合組織を改善するので添加するが、過剰添加はコストがアップし、脆性が悪化するので0.5%以下とする。Cuは集合組織を改善するので添加するが、過剰添加は熱延時の表面疵が増加するので1.0%以下とする。

【0013】なお、Ni、Sn、Cuの下限の量については磁気 特性を左右する集合組織改善効果の観点から、それぞれ Ni:0.1% Sn:0.01% Cu:0.05% を下限とする。次に製造方 法の限定理由について述べる。本発明者らは、スキンパ\* \*ス冷延前の結晶粒径[μπ]とスキンパス冷延率[%]につ いて検討した結果、図1に示すように両者の間には一定 の関係があることが分った。すなわち、スキンパス圧下 率は、高すぎると、引続く焼鈍において新たに再結晶核 が生成し、スキンパス冷延に続く焼鈍後の結晶粒径が微 細になり、ΔB1が向上しないので12%以下とする。スキ ンパス圧下率が低すぎると続く焼鈍において、粒成長の 駆動力が下がり、スキンパス冷延に続く焼鈍後の結晶粒 径が粗大化せず、ΔB1が向上しないので3%以上とする。 スキンパス冷延前の粒径が小さすぎると、スキンパス冷 延に続く焼鈍で粒成長する核が増加し、スキンパス冷延 に続く焼鈍後の結晶粒径が微細になるために、20μπ以 上とする。スキンパス冷延前の粒径を大きくしすぎる と、スキンパス冷延あとの形状が悪化するので200 μπ 以下とする。それら効果の間には、実施例で示すよう に、スキンパス冷延前の結晶粒径が50~200 μ m のとき は12% ≧スキンパス冷延率[%] ≧0.04×スキンパス前結 晶粒径[μm]+1の範囲で良好となるのでこの範囲とす る。ここで、B1とは、H が100[A/m]での磁束密度[T] を 示す。また、ΔB1とは、冷延、焼鈍後の材料を、スキン パス冷延を行なわずに焼鈍したときのB1と、スキンパス 冷延を行なって焼鈍したときのBIの差を意味する。

#### [0014]

## 【実施例】

(実施例1)以下に実施例を示す。出発素材を表1 に示す成分の鋼とし、工程を、熱延、冷延、焼鈍、スキンパス冷延後、750 ℃で2 時間保定後、炉冷とした。

#### [0015]

## 【表1】

鋼No.	C [ppm]	\$i [%]	Mn [%]	P [%]	S [ppm]	T. Al [%]	N [mqq]
1	28	0. 15	0. 17	0.068	22	0. 0015	. 14

【0016】表2 にスキンパス冷延前の結晶粒径とスキンパス冷延圧下率を様々に変化させた時の $\Delta$ B1を示す。スキンパス冷延前の粒径が $20\,\mu$ m 以上 $50\,\mu$ m 未満の場合には、スキンパス冷延圧下率を3%以上12% 以下とすることにより、 $\Delta$ B1が向上することがわかる。また、 $50\,\mu$ m 以上 $200\,\mu$ m 以下の場合は、12%  $\ge$  スキンパス率[%]  $\ge$  0.04× スキンパス前結晶粒径[ $\mu$ m]+1とすることにより  $\Delta$ B1が向上する。

[0017]

【表2】

5 表 2 実施例

鋼 No.	スキン/ス 圧延 前の結晶粒	スキンパス 圧延率	<b>∆B1</b>	備考
	径 [µm]	[%]	[T]	
1 1 1 1 1	22 22 22 22 22 22 22 22	0 3 4 5 9 12 15	≤ 0 0, 01 0, 02 0, 05 0, 03 0, 01 ≤ 0	比較例 本発明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明
1 1 1 1 1 1	51 51 51 51 51 51 51	0 3 4 5 9 12 15	≤ 0 0.03 0.1 0.08 0.1 0.03 ≤ 0	比較例 本発明例例 本発明明例例 本発明明例例 本発明明例 本発明例 比較例
1 1 1 1 1 1	103 103 103 103 103 103 103	0 3 4 5 9 12 15	≤ 0 ≤ 0 ≤ 0 0.03 0.14 0.02 ≤ 0	比较例例 化比较的明例例 本产 来 来 来 来 来 的 的 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例
1 1 1 1 1 1	198 198 198 198 198 198 198	0 3 4 5 9 12 15	≤ 0 ≤ 0 ≤ 0 ≤ 0 0.03 0.02 ≤ 0	比比較較較明明例 水 本 発 的

\*【0018】(実施例2)出発素材を表3に示す成分の 鋼とし、実施例1と同様の工程で無方向性電磁鋼板を製 造した。表4に示すようにNi、Sn、Cuを添加しても実施 例1と同様の効果があることがわかる。

【0019】 【表3】

10

20

ΔB1:磁化力100 [A/m] での磁束密度

\* 表3 成分

鋼No.	C [ppm]	\$i [%]	Mn [%]	P [%]	S [ppm]	T. A1 [%]	N (ppm)	ni [%]	Sn [%]	[%] Cu
2 3 4 5 6 7 8	28 28 28 28 28 28 28 28	0. 15 0. 15 0. 15 0. 15 0. 15 0. 15 0. 15	0. 17 0. 17 0. 17 0. 17 0. 17 0. 17 0. 17 0. 17	0. 068 0. 068 0. 068 0. 068 0. 068 0. 068 0. 068	22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	0. 0015 0. 0015 0. 0015 0. 0015 0. 0015 0. 0015 0. 0015	14 14 14 14 14 14	2.0 2.0 2.0 2.0	0. 50 0. 50 0. 50 0. 50	1.0 1.0 1.0 1.0

[0020]

【表4】

表 4 実施例

鋼 No.	スキンパス 圧延 前の結晶粒	みがな 圧延率	ΔB1	備考
·	径 [µm]	[%]	(T)	
2	32	0	≦ 0	比較例
	32	9	0.08	本発明例
	32	15	≦ 0	比較例
3	58	0	≦ 0	比較例
	58	9	0.1	本発明例
	58	15	≦ 0	比較例
4 .	· 88	0	0	比較例
	88	9	0. 05	本発明例
	88	15	≤ 0	比較例
5	92	0	0	比較例
	92	9	0.04	本発明例
	92	15	≤ 0	比較例
6	78	0	0	比較例
	78	9	0.03	本発明例
	78	15	≤ 0	比較例
7	67	0	0	比較例
	67	9	0.05	本発明例
	67	15	≤ 0	比較例
8	34	0	0	比較例
	34	9	0.04	本発明例
	34	15	≤ 0	比較例

\* [0021]

【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、低磁化力での磁束密度が高い無方向性電磁鋼板が得られ、高効率モータ用鉄心材料として用いられる無方向性電磁鋼板に対する要望に十分にこたえることができ、その工業的効果は非常に大きい。

【図面の簡単な説明】

【図1】スキンパス冷延前の結晶粒径とスキンパス冷延 圧下率の関係を示す。

10

20

【図1】

